

### 关键指标

频率: 8~12GHz  
增益: 27dB  
噪声系数: 1dB  
1dB 压缩点输出功率: 19dBm  
电压/电流: +5V/95mA  
芯片尺寸: 2mm×0.93mm×0.1mm

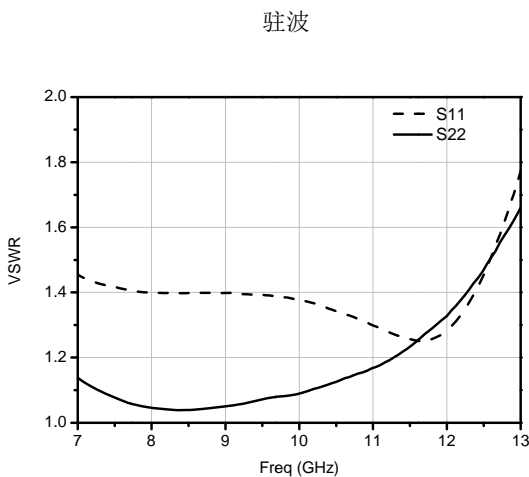
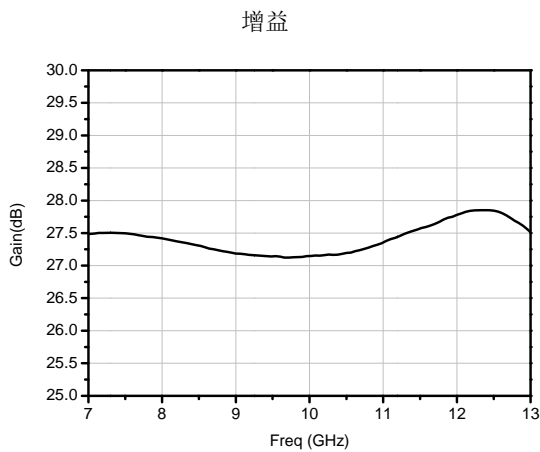
### 产品简介

HG115FQ 是一款 8~12GHz 低噪声放大器芯片, 增益为 27dB, 噪声系数为 1dB, 1dB 压缩点输出功率为 19dBm。

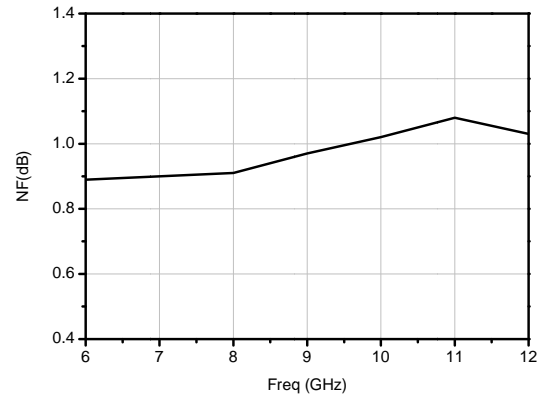
### 电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub> = +5V)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	8~12		
增益(dB)	-	27	-
增益平坦度(dB)	-	±0.5	-
噪声系数(dB)	-	1	-
输入驻波	-	1.4	-
输出驻波	-	1.1	-
1dB 压缩点输出功率(dBm)	-	19	-
静态电流 (mA)	-	95	-

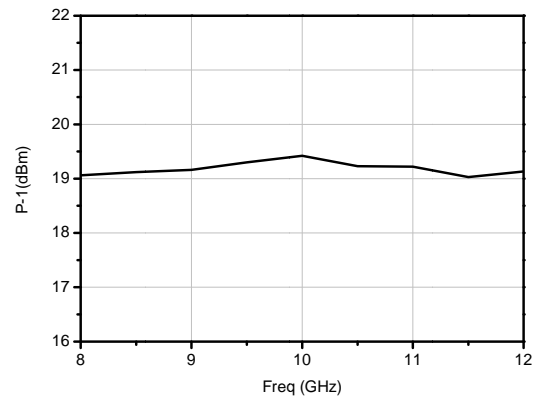
### 典型测试曲线



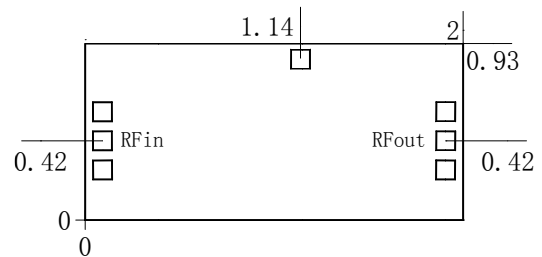
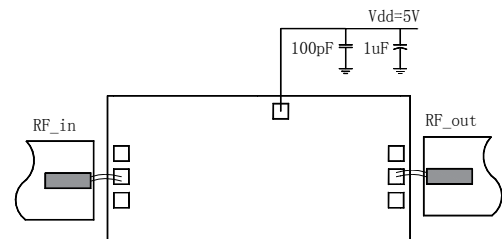
### 噪声系数



### 1dB 压缩点输出功率



### 外形和端口尺寸



### 绝对额定最大值

工作电压	+5.5V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。